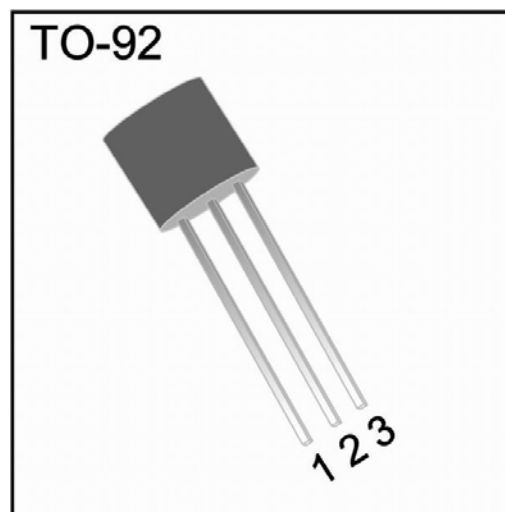
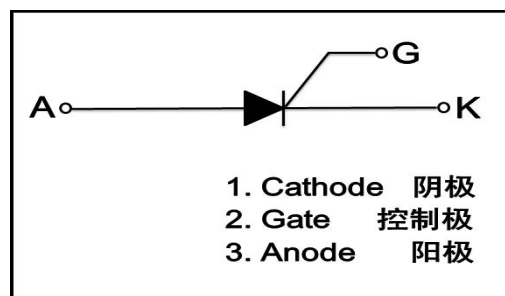


● 产品特征和主要用途

PNPN 四层结构的硅器件；采用双台面玻璃钝化工艺；
 保证了高电压的可靠性；背面多层金属化电极；提高了产
 品电流冲击的耐受力；门极灵敏触发；

主要用于：各种万能开关器；电子镇流器；漏电保护器；
 负离子发生器；臭氧发生器；摩托车点火器；LED 彩灯控
 制器；加热控制器（调温）；调光调速电路。



● 主要参数(FEATURES)

- $I_{T(RMS)} = 1.0A$
- $V_{DRM} = 600V$
- $I_{GT} \leq 200\mu A$

● 封装(Package Code)

- TO-92(TO-226)

● 极限参数(Absolute Maximum Ratings)

符号	参数名称	测试条件	数值	单位
V_{DRM}/V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$t_p=10ms, T_J=25^\circ C$	600	V
$I_{T(RMS)}$	通态方均电流	$T_c=60^\circ C$	1.0	A
I_{TSM}	通态浪涌电流	$F=60HZ, t=10ms$	10	A
I_t^2	I_t^2 的极限值	$t_p=8.3ms$	0.415	A^2S
I_{GM}	控制极峰值耗散电流	$t_p=1\mu S, T_c=125^\circ C$	1	A
P_{GM}	控制极峰值耗散功耗		2	W
$P_{G(AV)}$	控制极平均耗散功率	$T_J=125^\circ C$	0.1	W
T_{STG} T_J	储存温度 有效结温		-40~150 -40~125	$^\circ C$

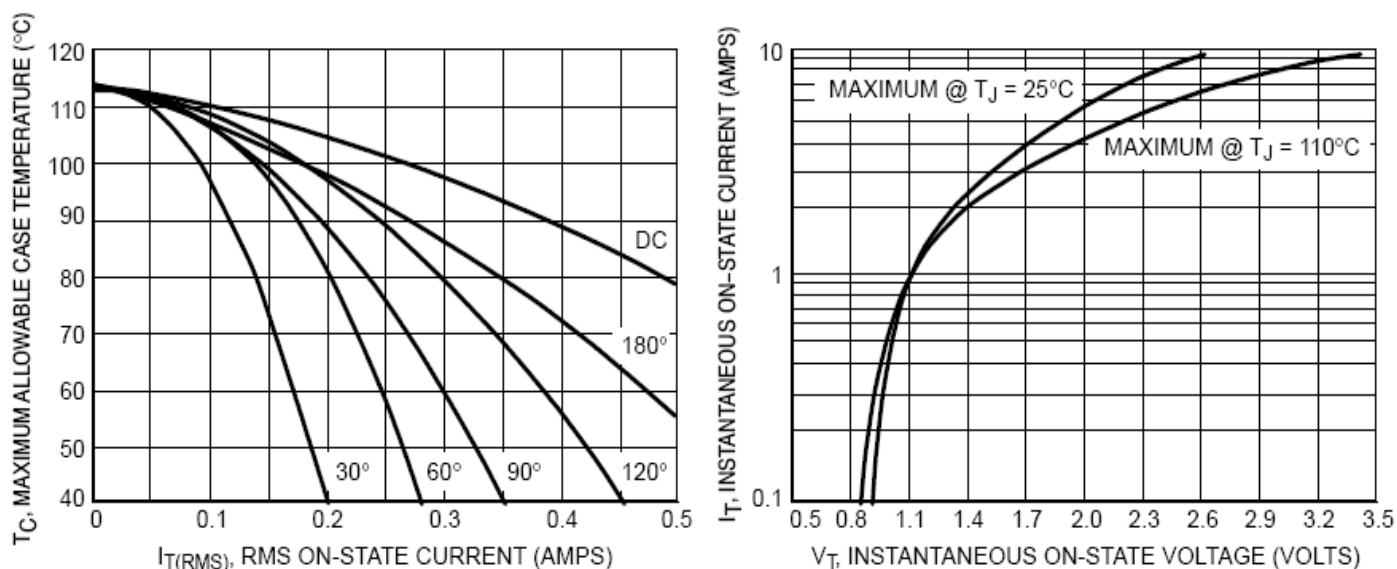
● 电特性(Electrical Characteristics)

符号	参数名称	测试条件	数值		单位
I_{DRM}/I_{RRM}	断态峰值电流 反向峰值电流	$V_D=V_{DRM}, V_R=V_{DRM}, R_{GR}=1K\Omega, T_J=125^\circ C$	MAX	0.1	mA
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=1A, t_p=380\mu s, T_J=25^\circ C$	MAX	1.7	V
I_{GT}	触发电流	$V_{DK}=7V, I_T=10mA, R_L=100\Omega$	T	5	μA
			A	10	
			B	30	
			H	60	
V_{GT}	触发电压		MAX	0.8	V
V_{GD}	控制极不触发电压	$V_D=V_{DRM}, R_{GR}=1K\Omega, T_J=125^\circ C$	MIN	0.1	V
dv/dt	断态电压上升率	$V_D=2/3V_{DRM}, R_{GR}=1K\Omega, T_J=125^\circ C$	MIN	25	V/ μs
di/dt	通态电流上升率	$I_{TM}=20A, P_W=10\mu s, I_{GT}=20mA$	MAX	50	A/ μs
I_H	维持电流	$V_D=7V, I_T=20mA, R_{GK}=1K\Omega$	MAX	5.0	mA

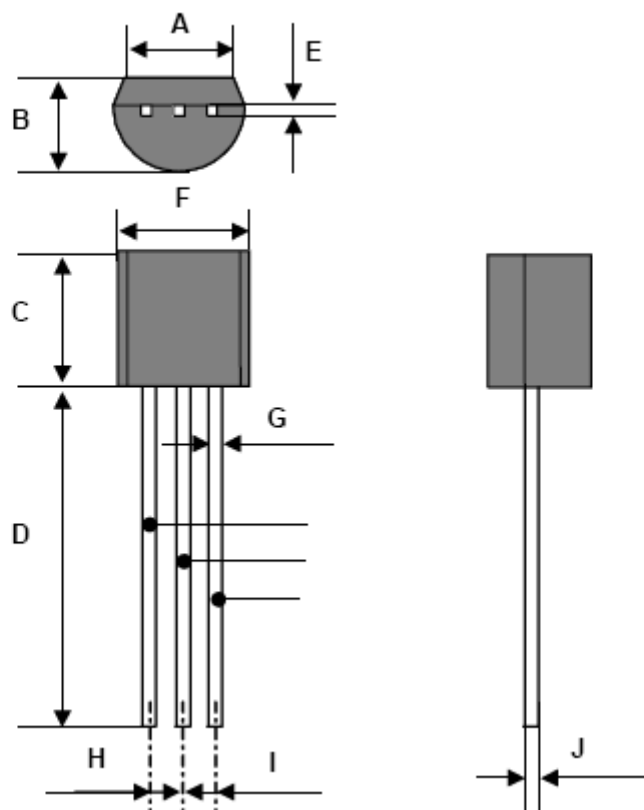
● 热阻(Thermal Resistance)

符号	参数名称	数值		单位
$R_{th(j-c)}$	热阻结到管壳	MAX	60	$^\circ C/W$
$R_{th(j-a)}$	热阻结到环境	MAX	180	$^\circ C/W$

● 典型特征(Typical Characteristics)



● TO-92 Package Dimension



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.300	3.700	0.130	0.146
A1	1.100	1.400	0.043	0.055
b	0.380	0.550	0.015	0.022
c	0.360	0.510	0.014	0.020
D	4.400	4.700	0.173	0.185
D1	3.430		0.135	
E	4.300	4.700	0.169	0.185
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	14.100	14.500	0.555	0.571
Φ		1.600		0.063
h	0.000	0.380	0.000	0.015